

634050, г. Томск, пр. Ленина, 40,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Томский государственный
университет систем управления и
радиоэлектроники».
Председателю диссертационного
совета Д 212.268.04 на базе Томского
государственного университета
систем управления и
радиоэлектроники,
д.ф-м.н., профессору
Шандарову С.М.

Уважаемый Станислав Михайлович!

Подтверждаю свое согласие на назначение официальным оппонентом по диссертационной работе Жидика Юрия Сергеевича «Прозрачные омические контакты для изделий гетероструктурной полупроводниковой оптоэлектроники» по специальности 01.04.04 – «Физическая электроника» на соискание ученой степени кандидата технических наук. Сведения, необходимые для размещения на сайте ТУСУР, прилагаются.

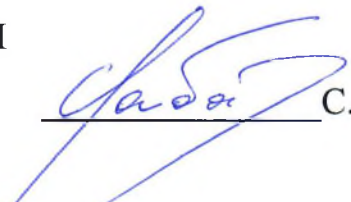
К.т.н.,

Н.с. лаб. прикладной электроники

Федерального государственного бюджетного

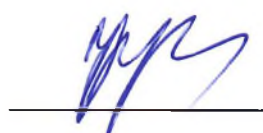
учреждения науки Институт сильноточной

электроники СО РАН


С.В. Работкин

Подпись н.с. Работкина С.В. удостоверяю

Ученый секретарь Института
сильноточной электроники СО
РАН





Сведения об официальном оппоненте

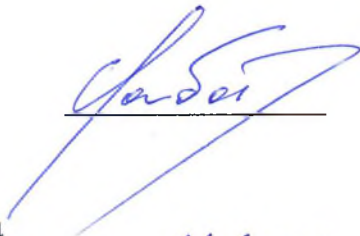
по диссертационной работе Жидика Юрия Сергеевича «Прозрачные омические контакты для изделий гетероструктурной полупроводниковой оптоэлектроники» по специальности 01.04.04 – «Физическая электроника» на соискание ученой степени кандидата технических наук.

Фамилия, имя, отчество	Работкин Сергей Викторович
Гражданство	Российская Федерация
Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	Кандидат технических наук, 05.27.02 - вакуумная и плазменная электроника
Ученое звание (по кафедре, специальности)	нет
Основное место работы	
Должность	Научный сотрудник
Наименование подразделения (кафедра, лаборатория)	лаборатория прикладной электроники
Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЭ СО РАН)
Почтовый индекс, адрес, веб-сайт, телефон, адрес электронной почты организации	Россия, 634055 г. Томск проспект Академический, 2/3 http://www.hcei.tsc.ru Тел.+7 (3822) 491-544 Факс. +7 (3822) 492-410 contact@hcei.tsc.ru
Публикации по специальности 01.04.04 – «Физическая электроника»» (4-5 за последние 5 лет, в том числе обязательно указание публикаций за последние три года)	
1. Solovyev, A.A., Rabotkin, S.V., Shipilova, A.V., Ionov, I.V. Magnetron sputtering of gadolinium-doped ceria electrolyte for intermediate temperature solid oxide fuel cells // International Journal of Electrochemical Science. - 2019.- Volume 14, Issue 1.-P . 575-584.	
2. Grenadyorov, A.S., Solovyev, A.A., Oskomov, K.V., Rabotkin, S.V., Elgin, Y.I., Sypchenko, V.S., Ivanova, N.M. Effect of substrate bias and substrate/plasma generator distance on properties of a-C:H:SiOx films synthesized by PACVD // Thin Solid Films. - 2019.-Vol. 669.-P . 253-261.	
3. Rabotkin S.V., Oskirko V.O., Ionov I.V., Semenov V.A., Shipilova A.V., Solovyev A.A. Process stabilization during reactive high power impulse magnetron sputtering of Ce/Gd target // Journal of Physics: Conference Series, 2018. - Volume 1115, Issue 3 - №. 032078.	

4. Grenadyorov A.S., Oskomov K.V., Solov'ev A.A., Rabotkin S.V., Zakharov A.N., Semenov V.A., Oskirko V.O., Yelgin Y.I., Korneva O.S. Properties of Nanocomposite Nickel-Carbon Films Deposited by Magnetron Sputtering// Russian Physics Journal, 2017. - Volume 60, Issue 8 – P. 1285-1290.

5. Rabotkin, S.V., Solovyev, A.A, Semenov, V.A, Oskirko, V.O, Oskomov, K.V., Zakharov, A.N., Properties of ultra-thin Cu films grown by high power pulsed magnetron sputtering // Thin Solid Films. - 2017.-Vol. 631.-P . 72-79.

Официальный оппонент



С.В. Работкин

Верно

Ученый секретарь Института
сильноточной электроники СО
РАН



И.В. Пегель

